размагниченном состоянии – то есть непосредственно после закалки и отпуска. Должна быть обеспечена и стабильность напряженности H<sub>m</sub> намагничивающего поля.

**Выводы.** Анализом зависимостей  $M_r$  сталей от температуры  $T_o$  отпуска установлено явление многократного расширения диапазона возможного изменения  $M_r$  сталей при структурных изменениях в них по мере снижения  $H_m$  по сравнению с диапазоном возможного изменения  $M_{rs}$  сталей при тех же структурных изменениях. Это соответствуют физике перемагничивания ферромагнитного материала в слабых магнитных полях. На основе использования этого явления даны рекомендации по использованию остаточной намагниченности  $M_r$  сталей на частных петлях магнитного гистерезиса для магнитного структурного анализа.

1. Тикадзуми, С. Физика ферромагнетизма. Магнитные характеристики и практические применения / С. Тикадзуми // М.: Мир, 1987. – 419 с.

- 2. Сандомирский, С. Г. Расчет и анализ размагничивающего фактора ферромагнитных тел / С.Г. Сандомирский // Мн.: Беларуская навука, 2015. – 244 с.
- Сандомирский, С. Г. Анализ структурной и фазовой чувствительности коэрцитивной силы частных петель гистерезиса сталей / С.Г. Сандомирский // Металлы. 2014. № 4. С.37 – 43.
- Сандомирский, С.Г. Анализ влияния режимов термической обработки сталей на их остаточную намагниченность на частных петлях магнитного гистерезиса / С.Г. Сандомирский // Сталь. 2016. № 4. С.55 – 59.
- Бида, Г.В. Магнитные свойства термообработанных сталей / Г.В. Бида, А.П. Ничипурук // Екатеринбург: УрО РАН, 2005. – 218 с

УДК 621.373.826

## СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТЕКЛОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ИТТРИЙ-АЛЮМИНИЕВЫХ БОРАТОВ С ИОНАМИ УЬ<sup>3+</sup> И Ег<sup>3+</sup>

Свибович И.В.<sup>1</sup>, Курильчик С.В.<sup>1</sup>, Горбаченя К.Н.<sup>1</sup>, Кисель В.Э.<sup>1</sup>, Напрасников Д.А.<sup>2</sup>, Мальцев В.В.<sup>2</sup>, Леонюк Н.И.<sup>2</sup>, Кулешов Н.В.<sup>1</sup> <sup>1</sup>Белорусский национальный технический университет Минск, Республика Беларусь

<sup>2</sup>Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Москва, Россия

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к исследованию новых материалов, соактивированных ионами Er<sup>3+</sup> и Yb<sup>3+</sup>, для использования в качестве активных сред твердотельных лазеров спектрального диапазона 1,5-1,6 мкм. Излучение в этой области является относительно безопасным для зрения, соответствует области минимальной материальной дисперсии и минимальных потерь в кварцевых волокнах (так называемое, «третье информационное окно»). Перспективными средами для таких лазеров являются новые стеклокристаллические композиты, сочетающие в себе свойства кристаллов и стекол.

В данной работе исследовались спектроскопические свойства новых стеклокристаллических композитов на основе кристалла иттрий-алюминиевого бората –  $YAI_3(BO_3)_4$  – с ионами эрбия ( $Er^{3+}$ ) и иттербия ( $Yb^{3+}$ ). Образцы для исследований были получены из монокристаллов путем их размалывания, добавления стеклообразующего компонента (оксида бора) и высокотемпературного прокаливания. Измерение спектров поглощения для образца с содержанием Er  $0.8 \times 10^{20}$  см<sup>-3</sup> и Yb  $5.8 \times 10^{20}$  см<sup>-3</sup> производилось на двухлучевом спектрофотометре CARY 5000 для спектральных областей, соответствующих энергетическому переходу ионов иттербия  ${}^{2}F_{7/2} \rightarrow {}^{2}F_{5/2}$  (рис. 1) и эрбия  ${}^{4}I_{15/2} \rightarrow {}^{4}I_{13/2}$  (рис. 2).



Рисунок 1 – Спектр коэффициента поглощения образца с содержанием Er  $0.8 \times 10^{20}$  см<sup>-3</sup> и Yb  $5.8 \times 10^{20}$  см<sup>-3</sup> в области 850-1050 нм

Измерение спектров люминесценции в области 1400-1690 нм производилось по методу синхронного детектирования при возбуждении на длине волны 976 нм. Результат изменения предствлен на рис. 3.



Рисунок 2 – Спектр коэффициента поглощения образца с содержанием Er  $0.8{\times}10^{20}~{\rm cm}^{-3}$  и Yb  $5.8{\times}10^{20}~{\rm cm}^{-3}$  в области 1400-1650 нм



Рисунок 3 – Спектр интенсивности люминесценции образца с содержанием Ег $0.8{\times}10^{20}~{\rm сm}^{-3}$  и Yb  $5.8{\times}10^{20}~{\rm cm}^{-3}$  в области 1400-1700 нм

Измерения временных характеристик люминесценции проводились для четырех образцов с различной концентрацией примесных ионов (см. таблицу 1). Измерения проводились по методу, позволяющему минимизировать влияние перепоглощения излучения люминесценции (повторного поглощения испущенных фотонов) из-за перекрытия спектров поглощения и люминесценции в квазитрехуровневых средах [1, 2].

Таблица 1. Концентрации примесных ионов в исследуемых образцах

| № образца | $N_{Yb}$ , ×10 <sup>20</sup> cm <sup>-3</sup> | $N_{Er}$ , ×10 <sup>20</sup> cm <sup>-3</sup> |
|-----------|---|---|
| 1         | 1,06  | -   |
| 2         | 5,8   | 1,06  |
| 3         | 5,8   | 2,11  |
| 4         | 5,8   | 4,23  |

Кинетики затухания с уровня  ${}^{2}F_{5/2}$  иона Yb<sup>3+</sup> (переход  ${}^{2}F_{5/2} \rightarrow {}^{2}F_{7/2}$ ) в образцах измерялись при возбуждении на длине волны 976 нм. Регистрация сигнала люминесценции производилась с помощью германиевого фотодетектора на длине волны 1080 нм. Для образца №1, активированного лишь ионами Yb3+, кинетики люминесценции затухали по моноэкспоненциальному закону и хорошо аппроксимировались экспоненциальной функцией (см. рисунок 4).



Рисунок 4 – Кинетики затухания люминесценции образца стеклокристаллического композита №1 в суспензии при максимальном разбавлении

При увеличении объема глицерина в суспензии постоянная времени затухания кинетики уменьшалась и выходила на близкое к стационарному значению при объеме глицерина более 0,8 мл. Это свидетельствует о том, что влияние перепоглощения излучения становилось не значительным. Полученное время жизни уровня  ${}^{2}F_{5/2}$  ионов Yb<sup>3+</sup> в образце стеклокристаллического композита на основе иттрий-алюминиевого бората, легированного только ионами иттербия, составило 700 мкс.

Для образцов стеклокристаллических композитов №2-4, соактивированных ионами Yb<sup>3</sup> и Ег<sup>3+</sup>, время затухания люминесценции на длине волны 1080 нм также уменьшалось при увеличении объема глицерина. Были получены следующие результаты: для образца №2 время жизни составило 144 мкс; для образца №3 – 67.5 мкс; для образца №4 – 30 мкс.

Для соактивированных образцов сигнал люминесценции характеризовался профилем затухания, отличным от экспоненциального. Время жизни уровня  ${}^{2}F_{5/2}$  ионов Yb<sup>3+</sup> в данном случае рассчитывалось по формуле [3]:

$$\tau_{ycp} = \frac{\int_{0}^{\infty} tI(t)dt}{\int_{0}^{\infty} I(t)dt}$$

Величина эффективности переноса энергии в соактивированных образцах рассчитывалась по формуле:

$$\eta_{Yb\to Er} = 1 - \frac{\tau}{\tau_0} \tag{2}$$

(1)

Люминесценция соактивированных образцов на длине волны 1570 нм, которая соответствует энергетическому переход  ${}^{4}I_{13/2} \rightarrow {}^{4}I_{15/2}$  ионов  $Er^{3+}$  затухала по одноэкспоненциальном закону для всех трех образцов (№2-4) и не изменялась при добавлении глицерина. Время затухания люминесценции ионов  $Er^{3+}$  сокращалось при увеличении содержания эрбия с 410 до 300 мкс, что, по всей вероятности, обусловлено влиянием концентрационного тушения. Наиболее близким к радиационному времени жизни уровня  ${}^{4}I_{13/2}$  ионов  $\mathrm{Er}^{3+}$  в стеклокристаллических композитах будет время затухания, измеренное в низко концентрированном образце №2, которое составило 410 мкс.

Полученные результаты по временам затухания люминесценции для всех исследованных образцов, а также рассчитанные значения эффективности переноса энергии представлены в таблице 2.

Таблица 2. Времена затухания люминесценции с уровня <sup>2</sup>F<sub>5/2</sub> ионов Yb<sup>3+</sup> и эффективности переноса энергии в исследуемых образцах

| № образца | $	au_{ m Yb}$ | $\eta_{Yb \rightarrow Er}$ , % |
|-----------|---------------|--------------------------------|
| 1         | 700           |                                |
| 2         | 144           | 79                             |
| 3         | 67,5          | 90                             |
| 4         | 30            | 96                             |

Таким образом, в данной работе измерены спектры поглощения, люминесценции и кинетики затухания люминесценции образцов стеклокристаллических композитов на основе иттрий-алюминиевого бората, активированного ионами Yb<sup>3+</sup>, и соактивированного ионами Er<sup>3+</sup> и Yb<sup>3+</sup> с различной концентрацией, определено время жизни уровня  ${}^{2}F_{5/2}$  ионов иттербия в исследуемом материале. Для соактивированных образцов рассчитаны значения эффективности переноса энергии от ионов иттербия к ионам эрбия.

- 1.Growth, optical characterization, and laser operation of a stoichiometric crystal KYb(WO4)2 / M.C. Pujol [et al] // Phys. Rev. B. – 2002. – Vol. 65, №16. – P. 165121-165131.
- Sumida, D.S. Effect of radiation trapping on fluorescence lifetime and emission cross section measurements in solid-state laser media / D.S. Sumida, T.Y. Fan // Opt. Lett. – 1994. – Vol.19. – P.1343-1345.
- З.Степанов, Б.И. Введение в теорию люминесценции / Б.И. Степанов, В.П. Грибковский Мн.: изд-во АН БССР, 1963. 443 с.
- Energy-transfer studies and efficient cw laser operation of a cw Er,Yb:YCOB laser at 1.5-1.6 μm / P. Burns [et al.] // Proc. SPIE. / SPIE. – Bellingham, 2003. – Vol. 4968. – P. 79-86.

УДК: 621.373:535

## ФАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЬЦЕВОГО ГАЗОВОГО ЛАЗЕРА В РЕЖИМЕ АВТОКОЛЕБАНИЙ

## Свирина Л.П.

Белорусский национальный технический университет Минск, Республика Беларусь

Целью данной работы является теоретическое исследование фазовых характеристик четырехчастотного кольцевого газового лазера (ЧКГЛ) с эллиптическими состояниями поляризации генерируемых волн в условиях нестационарной генерации.

Уравнения генерации для интенсивностей  $I_{1,2}^{\pm}$ и разностей фаз  $\Psi_{1,2} = \Psi_{1,2}^{+} - \Psi_{1,2}^{-}$  встречных волн с произвольными состояниями поляризации выведены на основе матричного формализма в [1]. Эллиптические состояния поляризации создаются при помещении в резонатор ЧКГЛ линейной фазовой пластинки и оптического вращателя. Матрицы Джонса такого резонатора для встречных направлений (±) имеют вид:

$$\hat{M}^{+} = \begin{pmatrix} e^{i\psi} & 0\\ 0 & e^{-i\psi} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\phi & -\sin\phi\\ \sin\phi & \cos\phi \end{pmatrix}, \hat{M}^{-} = \tilde{M}^{+}, \quad (1)$$

где  $\psi$  и  $\phi$  - величина линейной и циркулярной фазовой анизотропии,  $\sim$  означает транспонирование. Собственные значения матриц  $\hat{M}^{\pm}$  и разность частот однонаправленных волн определяются как:

$$\lambda_{1,2}^{\pm} = \cos 2\psi \cos 2\phi \pm \sqrt{\cos^2 2\psi \cos^2 2\phi} - 1, \qquad (2)$$

 $\omega_{c1}^{\pm} - \omega_{c2}^{\pm} = 2\arccos(\cos 2\psi \cos 2\phi)c/L,$ 

а состояния поляризации мод резонатора задаются соотношениями:

$$\gamma_{1M}^{+} = 1/2 \operatorname{arctg} \{-tg\phi\}, sh2\beta_{1M}^{+} = -\sin\phi ctg\psi, \quad (3)$$

$$\gamma_{1M}^{+} - \gamma_{2M}^{+} = \pi/2, \xi_{2M}^{+} = -\xi_{1M}^{+},$$
(4)

$$\gamma_{1M,2M}^{-} = \gamma_{1M,2M}^{+}, \xi_{1M,2M}^{-} = -\xi_{1M,2M}^{+}.$$

Здесь  $\gamma$  – азимут,  $\xi = th 2\beta$  – эллиптичность,

знаки  $\pm$  отнесены к встречным направлениям распространения волн, цифры 1,2 обозначают номер резонаторной моды. Как следует из (3) (4), однонаправленные волны поляризованы ортогонально, а встречные волны, соответствующие одинаковым модам резонатора, – неортогонально: их азимуты одинаковы, а эллиптичности противоположны по знаку.

Для рассматриваемого ЧКГЛ характерно наличие большого числа экспериментально регулируемых параметров, поэтому вначале на основе численного интегрирования уравнений генерации при параметрах резонатора и активной среды, типичных для  $He - Ne (\lambda = 1.15 \text{ мкм})$